

JEAN-LUC BISCHOFF

Professeur des universités
Université de Haute Alsace

Jean-Luc BISCHOFF est professeur de physique (section CNU28) à l'Université de Haute Alsace. Après un doctorat soutenu en 1989 et une habilitation à diriger des recherches présentées en 2002, il est nommé professeur à l'Université de Haute Alsace en 2003. Il effectue ses travaux de recherche à l'Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M, UMR UHA CNRS 7361) où il dirige une équipe de recherche en physique expérimentale jusqu'en 2012. Il est expert dans l'élaboration par épitaxie et la caractérisation de nanomatériaux semiconducteurs (à base de silicium, germanium et carbone) ou métalliques (Fe) sur divers substrats semiconducteurs et isolants ayant des applications en nanoélectronique (clés USB ...), en optoélectronique. Il est co-auteur de 82 publications scientifiques (cosignés avec 84 co-auteurs) et de 141 communications présentées dans des conférences internationales ou nationales.

Tout d'abord membre du conseil scientifique de l'IS2M, il est ensuite vice-président de l'UHA de 2012 à 2020, en charge de la recherche, de la valorisation et de la formation doctorale. Dans ce cadre, il a assumé de nombreuses responsabilités locales, régionales, nationales et finalement internationales.

Autres responsabilités exercées

- Vice-président recherche, valorisation et formation doctorale à l'UHA (2012-2020)
- Vice-président du Collège Doctoral du site Université de Strasbourg (2013-2020)
- Vice-président du pôle de compétitivité Materalialia (depuis 2020)
- Membre du CA de la SATT Conectus (2012-2020)
- Président délégué de SEMIA, l'incubateur d'entreprises, puis membre du CA (2012-2020)
- Membre du R10 (gouvernance de la recherche et de l'innovation de la Région Grand Est) (2017-2020)
- Membre du réseau national, puis du bureau, des Vice-présidents recherche et valorisation (2012-2020)
- Membre du comité d'évaluation scientifique CE24 à l'ANR (2018)
- Campus France, représentant du réseau des VP recherche (commission recherche) (2018-2020)
- Membre du réseau des VP recherche d'EUCOR-Le campus européen (2012-2020)
- Responsable scientifique de la coopération bilatérale UHA - Université Libanaise de Beyrouth (Liban) (depuis 2000) et membre du consortium de l'Université Française d'Égypte (UFE) (depuis 2019)
- Référent science ouverte de l'UHA (2019-2021)
- Membre du jury régional des *Trophées de l'innovation du Grand Est* (2019 et 2020)
- Membre du jury du concours *Yago Talents d'entrepreneurs Alsace* (2018)

- Membre et Président du jury du concours régional (Alsace) *Ma thèse en 180 secondes* (2015-2019)
- Expert HCERES pour l'évaluation de la gouvernance d'un établissement de l'enseignement supérieur (2021)

Principales publications

- Use of multilayer techniques for simultaneous XPS recognition of various nitrogen environments in the Si/NH₃ system. **J.L. BISCHOFF, F. LUTZ, D. BOLMONT and L. KUBLER**, Surface Science 251/252, 170-174 (1991)
- Use of multilayer techniques for simultaneous XPS recognition of various nitrogen environments in the Si/NH₃ system. **J.L. BISCHOFF, F. LUTZ, D. BOLMONT and L. KUBLER**, Surface Science 251/252, 170-174 (1991)
- 6H-SiC{0001} x-ray photoelectron diffraction characterization used for polarity determination. **J.L. BISCHOFF, D. DENTEL and L. KUBLER**, Surface Science 415, 3, 392-402 (1998)
- Si adatom surface migration biasing by elastic strain gradients during capping of Ge or Si1-xGex hut islands. **L. KUBLER, D. DENTEL, J.L. BISCHOFF, C. GHICA C., UHLAQ-BOUILLET and J. WERCKMANN**, Applied Physics Letters 73, 8, 1053-1055 (1998)
- Atomic structure of carbon-induced Si(001)c(4x4) reconstruction as a Si-Si homodimer and C-Si heterodimer network. **L. SIMON, M. STOFFEL, P. SONNET, L. KUBLER, L. STAUFFER, A. SELLONI, A. De VITA, R. CAR, C. PIRRI, G. GARREAU, D. AUBEL and J.L. BISCHOFF**, Physical Review B 64, 035306-1 (2001)
- Resonant Raman scattering by acoustic phonons in self assembled quantum dot multilayers : from a few layers to superlattices. **M. CAZAYOUS, J. GROENEN, A. ZWICK, A. MLAYAH, R. CARLES, J.L. BISCHOFF and D. DENTEL**, Physical Review B 66, 195320/1-7 (2002)
- Bidimensional intercalation of Ge between 4H-SiC(0001) and a heteroepitaxial top layer. **L. KUBLER, K. AIT-MANSOUR, M. DIANI, D. DENTEL, J.L. BISCHOFF and M. DERIVAZ**, Physical Review B 72, 115319/1-10 (2005)
- Original Ge-induced phenomena on various SiC(0001) reconstructions. **K. AIT-MANSOUR, D. DENTEL, L. KUBLER, M. DIANI, M. DERIVAZ and J.L. BISCHOFF**, Journal of Physics D : Applied Physics 40, 1-17 (2007)
- Strain Relief : mainspring of Ge semiconducting nanostructures growth on LaAlO₃(001). **D. DENTEL, H. MORTADA, M. DERIVAZ, J.L. BISCHOFF, E. DENYS, F. M. MORALES, M. HERRERA, J. M. MANUEL and R. GARCIA**, Acta Materialia, 60, 1929-1936 (2012)
- Grafting process of ethyltrimethoxysilane and polyphosphoric acid on calcium carbonate surface. **J. KIEHL, C. BEN AZZOUZ, D. DENTEL, M. DERIVAZ, J.L. BISCHOFF, C. DELAITE and S. BISTAC**, Applied Surface Science, 264, 864-871 (2013)
- Epitaxial growth of Fe islands on LaAlO₃(001) substrates. **M. ZANOUNI, C. BEN AZZOUZ, M. DERIVAZ, D. DENTEL, E. DENYS, M. DIANI, A. AOUNI, F. M. MORALES, J. M. MANUEL, R. GARCIA and J.L. BISCHOFF**, Journal of Crystal Growth 391, 121-129 (2014)

